

IV1Q12050D7Z- 1200V 50mΩ 车规级 SiC MOSFET

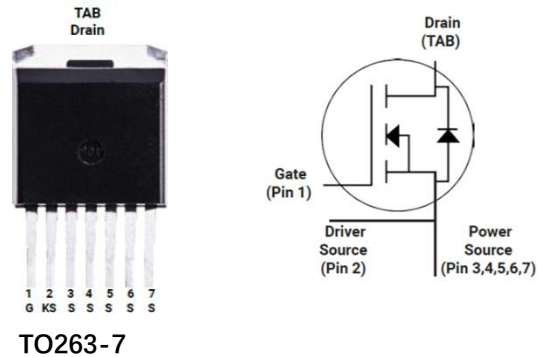
特点

- 具有源极驱动管脚的低阻抗封装
- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管

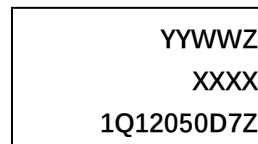
应用

- 光伏逆变器
- 车载充电器
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

封装示意图:



丝印示意图:



1Q12050D7Z = Specific Device Code
 YY = Year
 WW = Work Week
 Z = Assembly Location
 XXXX = Lot Traceability

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	<1%占空比, 脉冲宽度 <200ns	
V _{GSon}	推荐使用的开通栅源电压	20±0.5	V		
V _{GSoff}	推荐使用的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	50	A	V _{GS} =20V, T _C =25°C	图 21
		37	A	V _{GS} =20V, T _C =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	125	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	240	W	T _C =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		

热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R _{θ(J-C)}	结到外壳的热阻	0.623	°C/W	图 23

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{TH}	阈值电压	1.8	3.2	5	V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =6mA	图 8, 9
			2.2			V _{GS} =V _{DS} , I _D =6mA @ T _c =175°C	
R _{ON}	导通电阻		50	65	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =20A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			80		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =20A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		2750		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=1MHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{oss}	输出电容		106		pF		
C _{rss}	反向传输电容		5.2		pF		
E _{oss}	输出电容存储能量		43		μJ		图 17
Q _g	栅极总电荷		120		nC	V _{DS} =800V, I _D =20A, V _{GS} =-5 to 20V	图 18
Q _{gs}	栅源电荷		25		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		48		nC		
R _g	栅极输入电阻		2.8		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	导通能量		496.5		μJ	V _{DS} =800V, I _D =30A, V _{GS} =-3.5 to 20V, R _{G(ext)} =3.3Ω, L=270μH	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		93		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		13.8		ns		
t _r	上升时间		21.2				
t _{d(off)}	关断延迟时间		25.4				
t _f	下降时间		12.6				

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		4.9		V	I _{SD} =20A, V _{GS} =0V	图 10, 11, 12
			4.4		V	I _{SD} =20A, V _{GS} =0V, T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		49.1		ns	V _{GS} =-3.5 to 20V, V _{DS} =800V, I _D =30A, di/dt=2A/ns	
Q _{rr}	反向恢复电荷		289		nC		
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		13.76		A	R _{G(ext)} =20Ω, L=270μH	

典型特征曲线

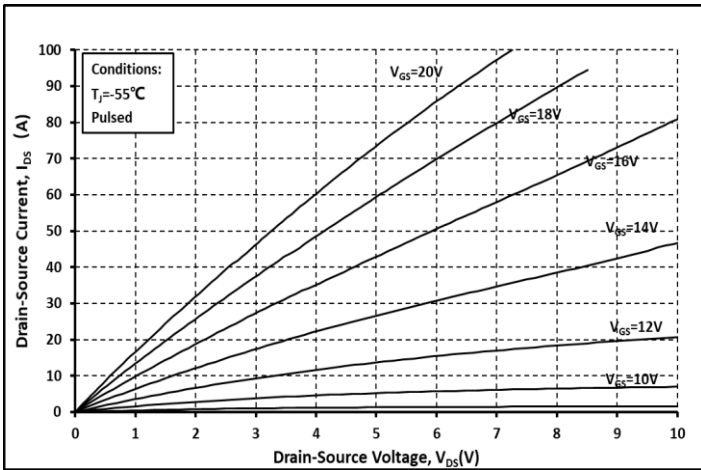


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

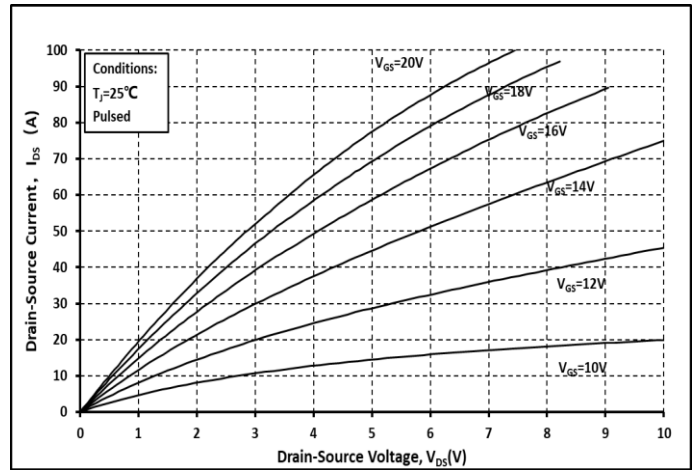


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

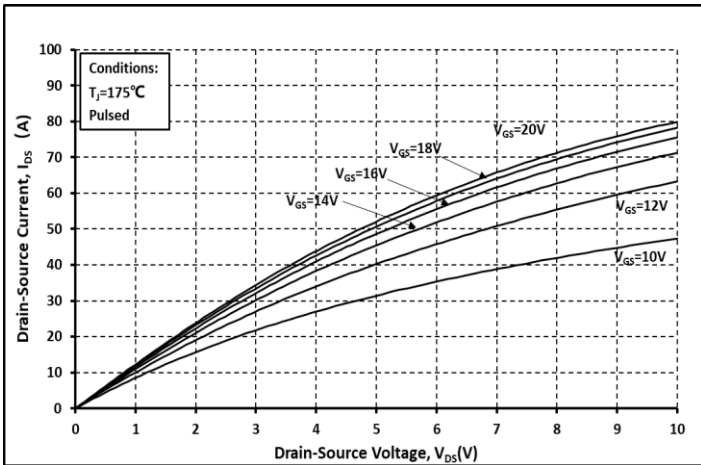


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

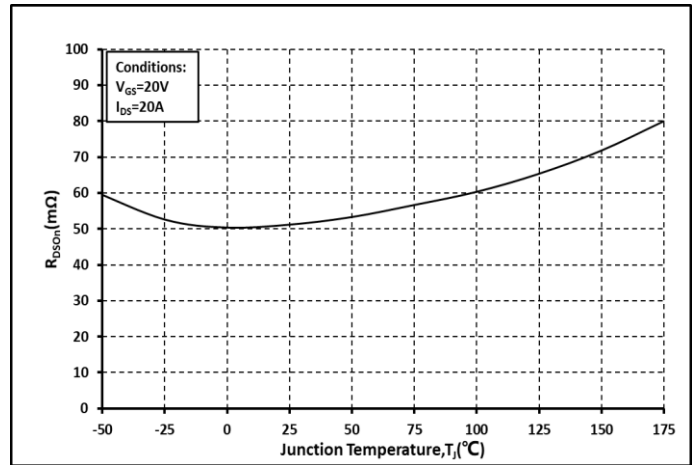


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

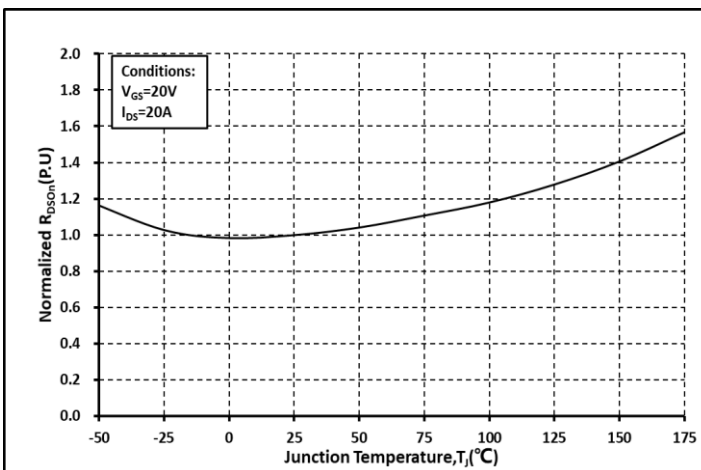


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

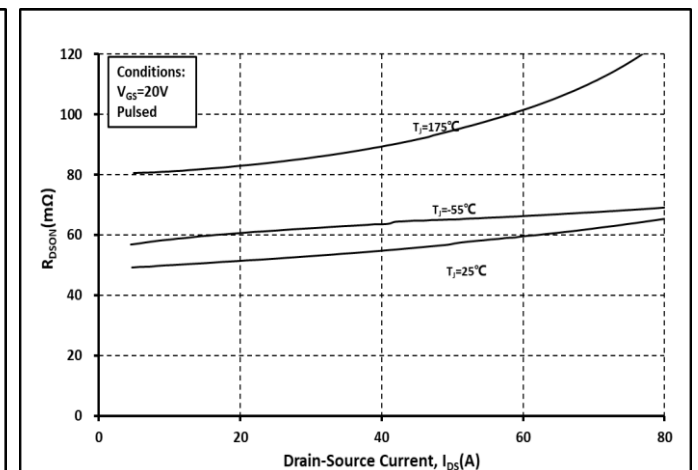


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{ds} 关系曲线

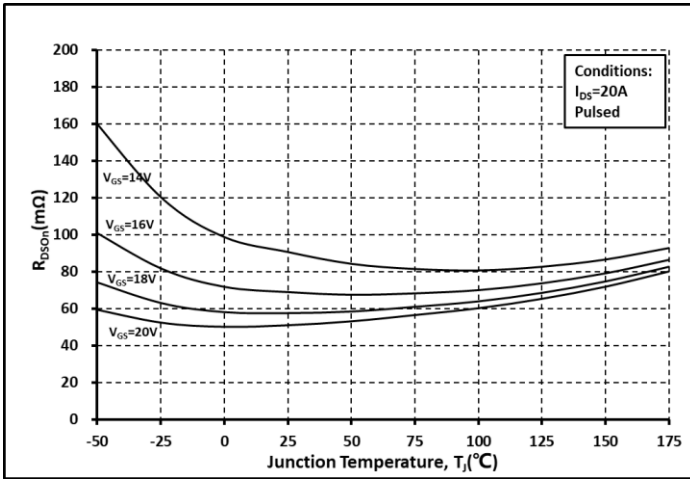


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

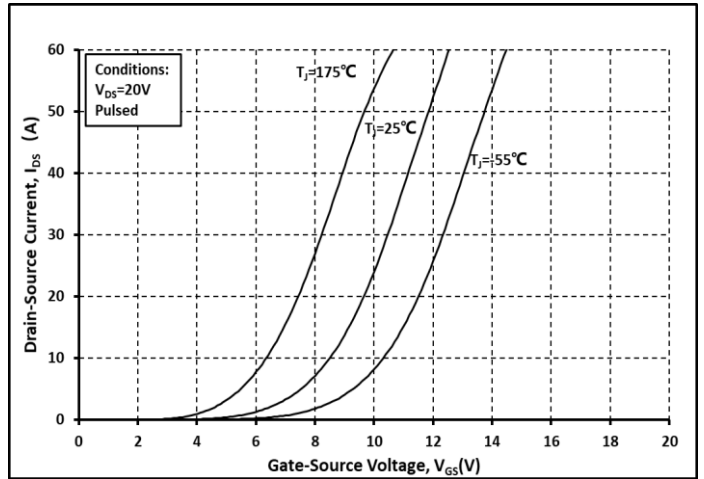


图. 8 各温度下的传输特性曲线

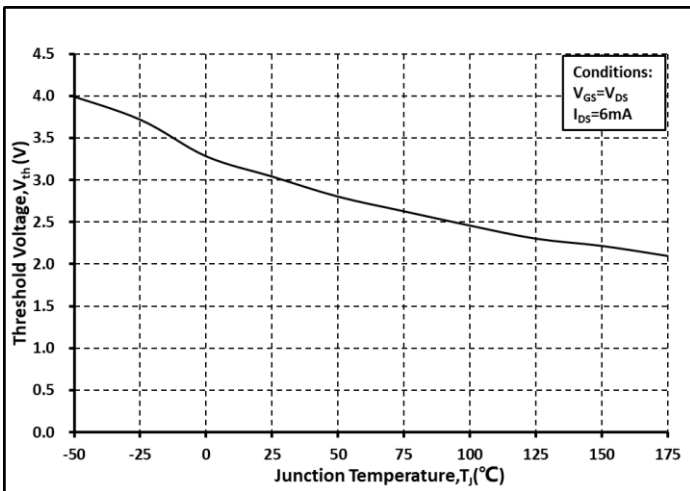


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

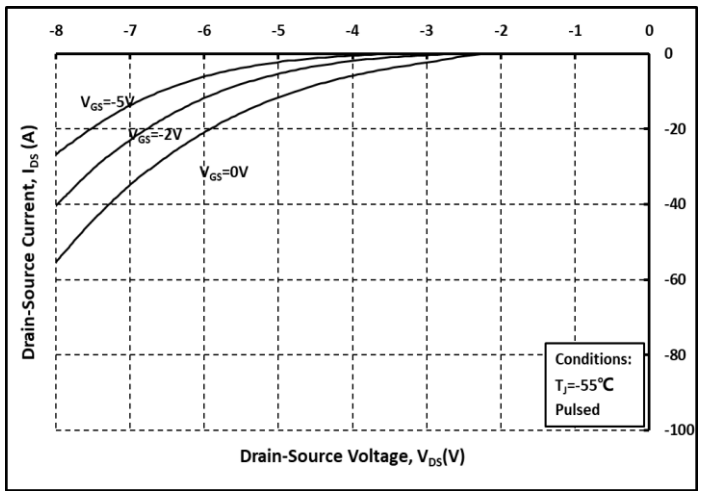


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_J = -55^\circ C$

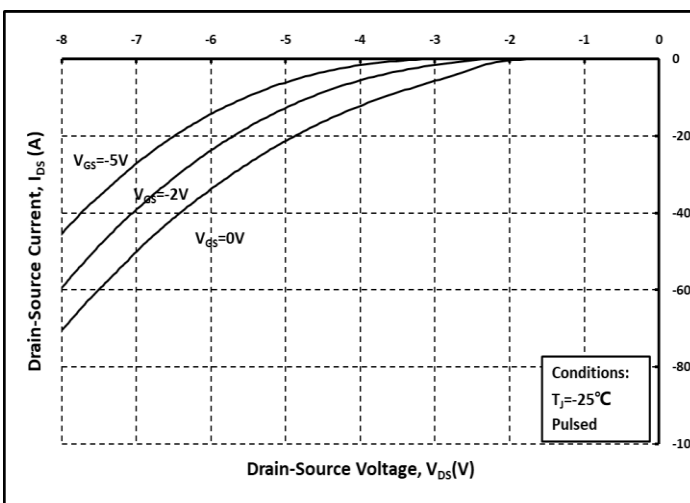


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_J = 25^\circ C$

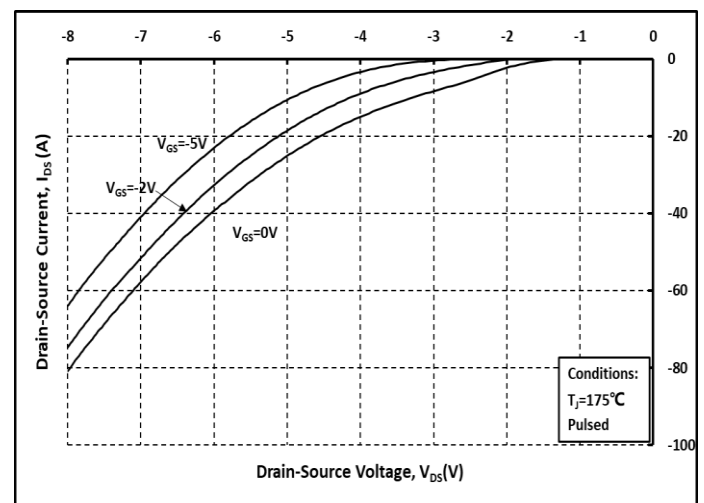


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_J = 175^\circ C$

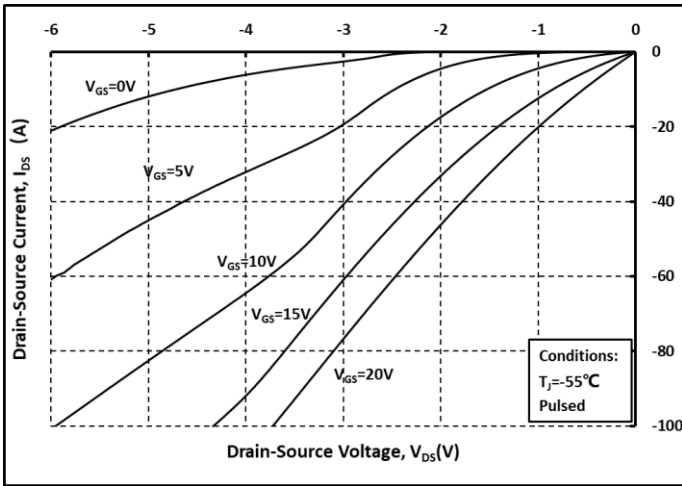


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

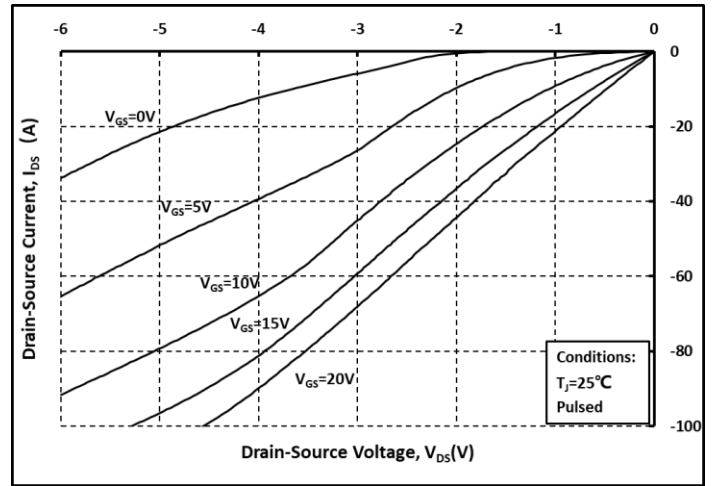


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

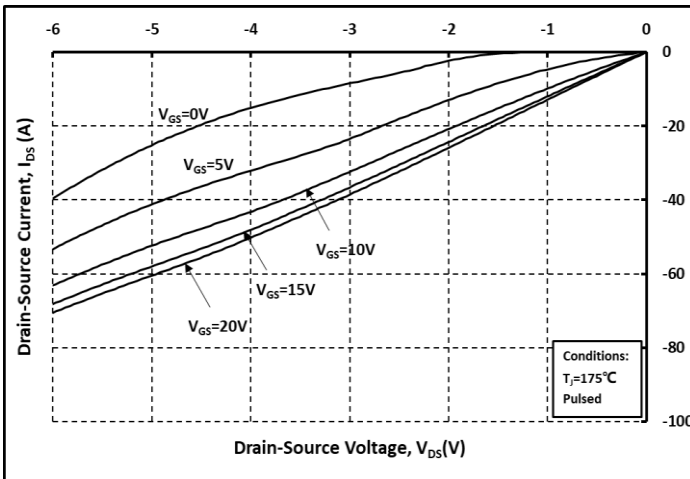


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

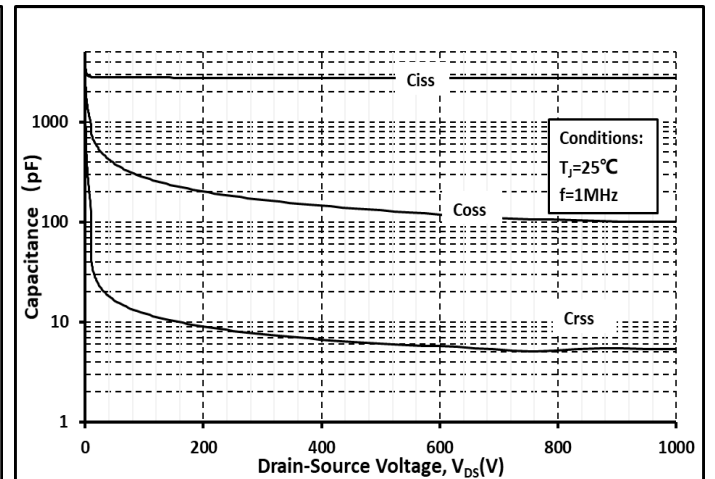


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

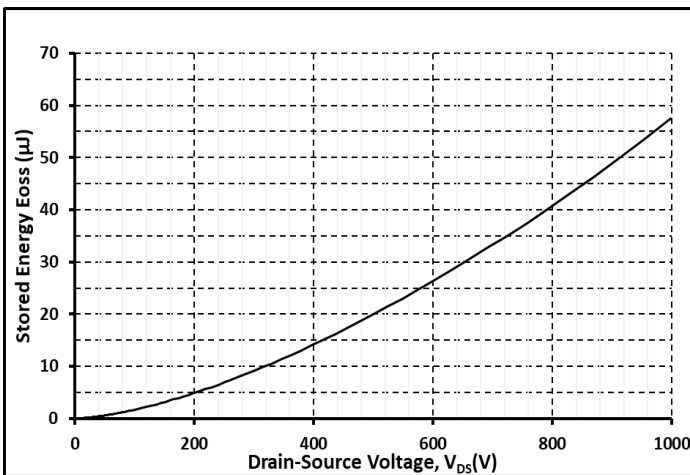


图. 17 输出电容存储能量曲线

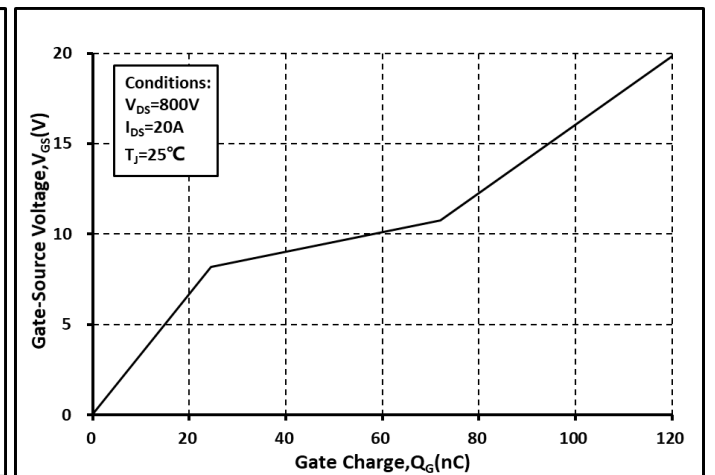


图. 18 栅电荷特征曲线

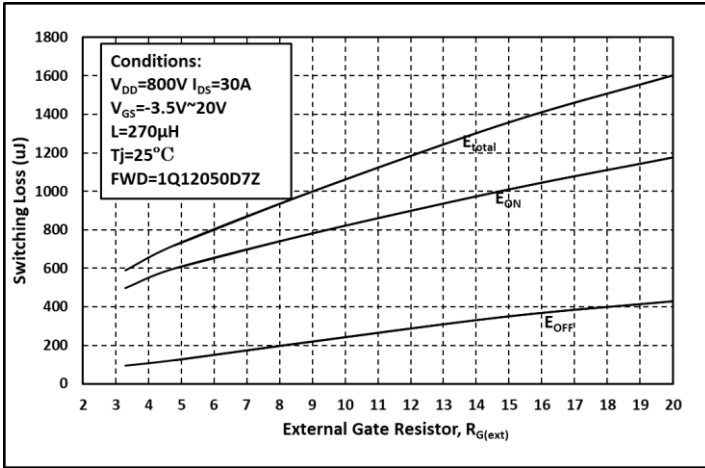


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

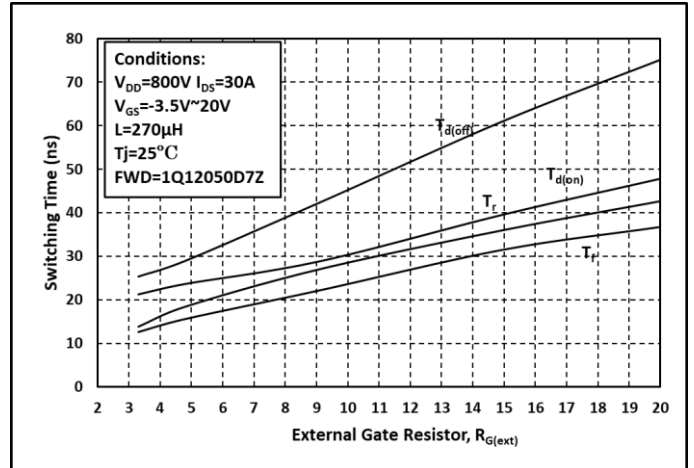


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

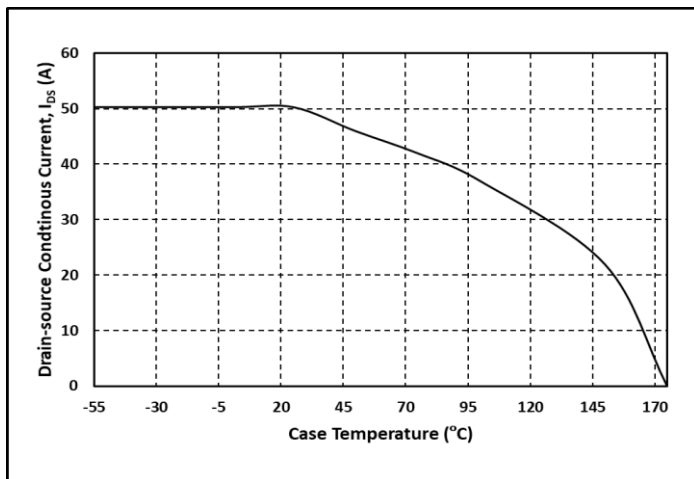


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

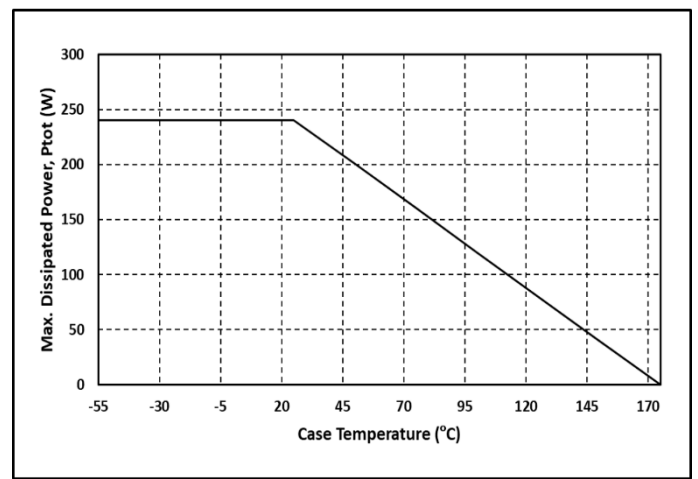


图. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

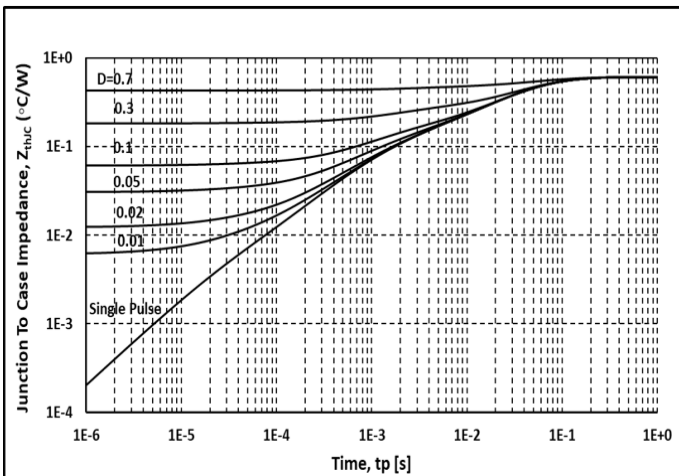


图. 23 热阻曲线

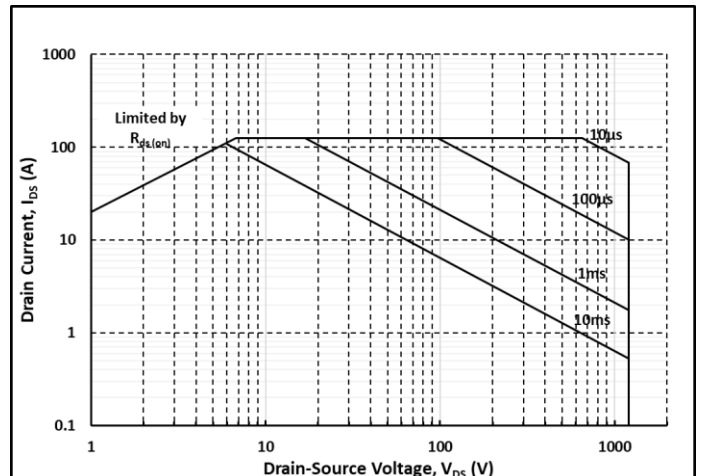
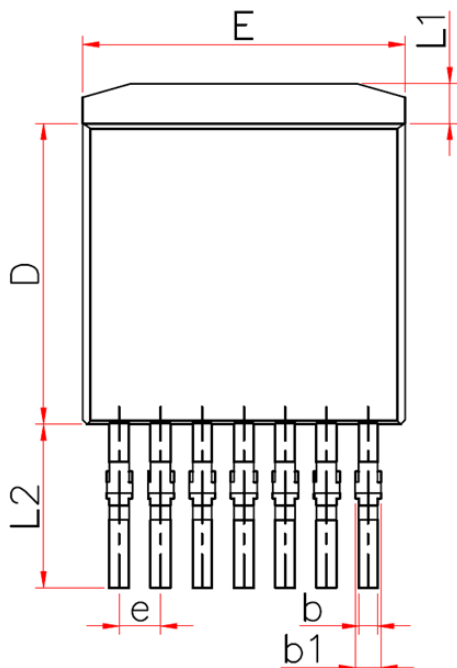
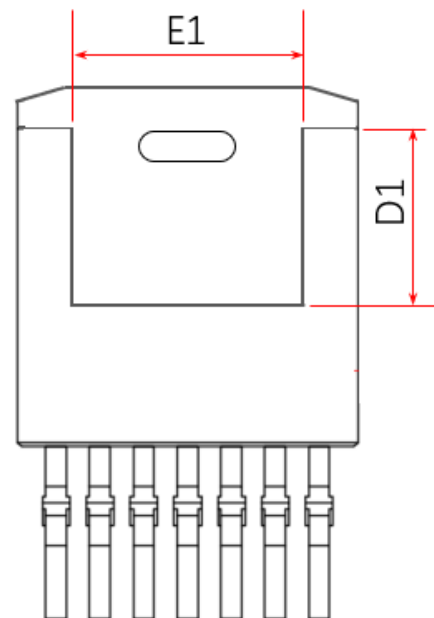
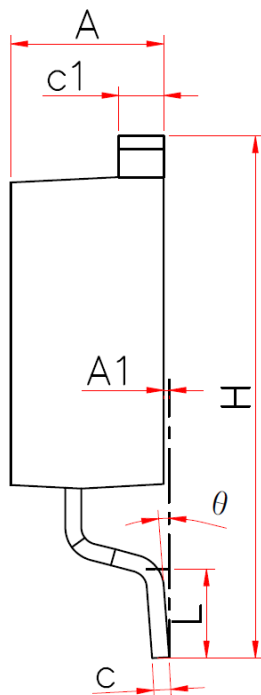


图. 24 安全工作区示意图

封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min.	Max.
A	4.300	4.700
A1	—	0.250
b	0.500	0.700
b1	0.600	0.900
c	0.400	0.600
c1	1.200	1.400
D	8.930	9.400
D1	7.700	—
E	9.700	10.280
E1	8.380	8.780
e	1.27 REF.	
H	15.000	16.000
L	1.900	2.840
L1	0.980	1.420
L2	4.800	5.200
θ	0°	8°



说明:

1. 封装标准参考: JEDEC TO263, Variation AD
2. 以上单位为: 毫米
3. 如有变更, 不另行通知

说明

欲了解更多产品信息，请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2022 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip](#)